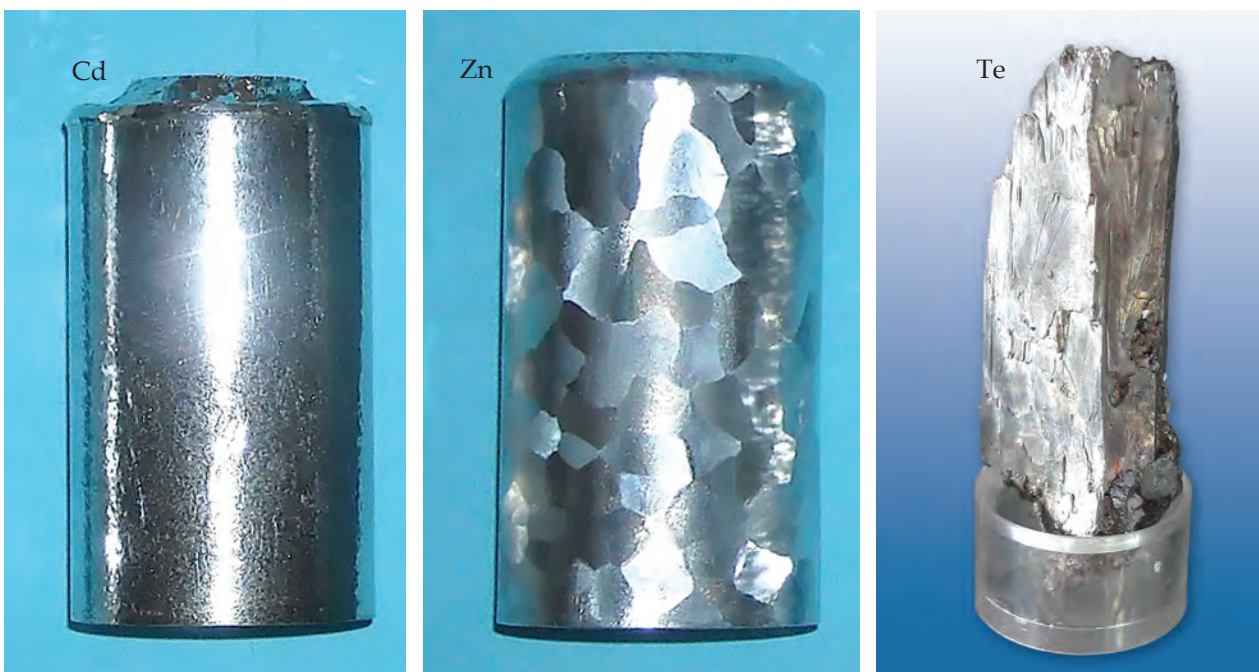


## ПРИСТРІЙ ГЛИБОКОГО ОЧИЩЕННЯ Cd, Zn I Te



### Призначення

Для отримання напівпровідникових і сцинтиляційних кристалів для детекторів іонізуючого випромінювання

### Характеристики

Маса початкового завантаження матеріалу, кг	2,5
Вихід продукту, % початкового завантаження	90
Продуктивність пристрою, г/год	300 – 400
Потужність загальна, кВт	≤3
Робоча температура, °С	350 – 650
Чистота, %	99,9 – 99,99... >99,999 – 99,9999

### Переваги

Унікальне для України обладнання.  
Глибоке очищення від широкого спектра домішкових елементів.  
Висока продуктивність процесу рафінування та вихід придатного продукту

### Охорона інтелектуальної власності

IPR3

### Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL6, TRL6  
Виготовлення чистих металів на замовлення

### Контактна інформація

Пугач Сергій Григорович, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, +38 057 335 68 43, +38 057 349 10 49, e-mail: pugach@kipt.kharkov.ua